

제20회 한국반도체학술대회

2013년 2월 4일(월)~6일(수) / 웰리힐리파크 (구, 성우리조트)

우) 302-120 대전광역시 서구 둔산동 1018번지 대한빌딩 5층 / 담당: 최은영 팀장, 김아영
TEL: (042) 472 -7461 FAX: (042) 472 -7459 E-mail: kcs@cosar.or.kr

E. Compound Semiconductors 분과

Room F

죽실 (본관, 5층)

2013년 2월 6일(수) 12:45-14:00

[WF2-E] Compound Semiconductor V

좌장: 민병규(한국전자통신연구원), 이정희(경북대학교)

- | | | |
|---------|-------------|--|
| WF2-E-1 | 12:45-13:00 | 고온 저장 시험에 의한 GaN HEMT 소자의 특성 변화
이종민, 민병규, 주철원, 임종원, 안호균, 문재경, 남은수
한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부
RF 융합부품연구팀 |
| WF2-E-2 | 13:00-13:15 | Polyimide를 이용한 AlGaIn/GaN HFET의 Chip크기 감소 및 신뢰성 향상
오승규 ¹ , 조영제 ² , 송치균 ¹ , 장태훈 ² , 곽준섭 ¹
¹ 순천대학교 인쇄전자공학과, ² LG 전자 System IC 연구소 IGBT part |
| WF2-E-3 | 13:15-13:30 | Packaged AlGaIn/GaN HEMT with 100 W Output Power at 3 GHz
임종원, 안호균, 강동민, 김성일, 이종민, 이상홍, 민병규, 윤형섭, 주철원,
김해천, 문재경, 남은수
한국전자통신연구원 융합부품소재연구부문 광무선융합부품연구부
RF 융합부품연구팀 |
| WF2-E-4 | 13:30-13:45 | 게이트가 장착된 오믹 애노드를 이용한 낮은 문턱전압의 AlGaIn/GaN-on-Si 다이오드 개발
이재길 ¹ , 박봉렬 ¹ , 최신희 ¹ , 이민성 ² , 서광석 ² , 김형탁 ¹ , 차호영 ¹
¹ 홍익대학교 전자전기공학부, ² 서울대학교 전기컴퓨터공학부 |
| WF2-E-5 | 13:45-14:00 | Growth and Device Performance of AlGaIn/GaN Heterostructure on SiC Substrate using High Temperature AlN Buffer Layer
R. H. Kim ¹ , K. S. Im ¹ , D. S. Kim ¹ , Y. W. Jo ¹ , C. H. Won ¹ , K. I. Jang ¹ , M. K. Kwon ¹ , S. M. Jeon ¹ , D. H. Son ¹ , B. H. Lee ² , B. O. Lim ² , G. W. Choi ² , J. M. Lee ³ , J. S. Lee ³ , and J. H. Lee ¹
¹ School of Electrical Engineering & Computer Science, Kyungpook National University, ² Samsung Thales Co., Ltd., ³ Agency for Defense Development |